

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«РАДІАЦІЙНА ФІЗИКА НАПІВПРОВІДНИКІВ»

Галузь знань	<i>10 – Природничі науки</i>
Спеціальність	<i>104 – Фізика та астрономія</i>
Освітня програма	<i>Фізика ядра, фізика елементарних частинок і високих енергій; ядерно-фізичні установки; радіаційна фізика конденсованого стану; фізика плазми і ядерного синтезу</i>
Освітній рівень	<i>доктор філософії</i>
Статус дисципліни	<i>Фаховий / Вибірковий</i>
Мова викладання	<i>Українська</i>
Курс / семестр	<i>II курс, 1 і 2 семестр</i>
Кількість кредитів ЄКТС	<i>4 кредити ЄКТС</i>
Розподіл за видами занять та годинами навчання	<i>Лекції – 32 год.</i>
	<i>Практичні (семінарські) – 16 год.</i>
	<i>Консультація – 4 год.</i>
	<i>Самостійна робота – 68 год.</i>
Форма підсумкового контролю	<i>Іспит</i>
Відділ	<i>Відділ радіаційної фізики ІЯД НАН України, корп. 101</i>
Викладач (-і)	<i>Малий Євген Вікторович, ст. наук. співроб., к.ф.-м.н.</i>
Контактна інформація викладача (-ів)	<i>evgen.malyj@gmail.com, +380636771724</i>
Дні занять	<i>За розкладом</i>
Консультації	<i>Дистанційні, за домовленістю з ініціативи здобувача, групові</i>

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Мета навчальної дисципліни – формування у аспірантів компетентностей та оволодіння фундаментальними поняттями у галузі радіаційної фізики напівпровідників, які дозволятимуть формулювати задачу і ставити експеримент з метою визначення необхідних величин, які характеризують поведінку об'єкта у полі проникного опромінення

Предмет навчальної дисципліни – вивчення впливу проникного опромінення на зміну фізичних параметрів напівпровідникових сполук

Компетентності

Інтегральна компетентність (ІК): Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми науково-дослідницької та/або розробницької, та/або інноваційної діяльності у сфері фізики та/або астрономії, застосовувати методологію науково-дослідницької та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК02. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК03. Здатність розв'язувати комплексні наукові проблеми на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням професійної етики та академічної доброчесності.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері фізики та/або астрономії, інтегрувати знання з різних галузей, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.

СК02. Здатність відстежувати тенденції розвитку фізики та/або астрономії, їх прикладних застосувань, критично переосмислювати наявні знання та методи фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

СК03. Здатність представляти та обговорювати результати своєї науково-дослідницької роботи державною мовою, а також англійською мовою чи одною з офіційних мов Європейського Союзу, в усній та в письмовій формі, опрацьовувати наукову літературу з фізики та/або астрономії і ефективно використовувати нову інформацію з різних джерел.

СК04. Здатність організовувати та здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері фізики та/або астрономії.

СК05. Здатність ініціювати, розробляти та реалізовувати науково-дослідницькі, розробницькі та інноваційні проекти у сфері фізики та/або астрономії, планувати й організовувати

роботу науково-дослідницьких, розробницьких та інноваційних колективів.

СК06. Здатність застосовувати сучасні методи, методики, технології, інструменти та обладнання для проведення прикладних та фундаментальних наукових досліджень у галузі фізики та/або астрономії.

Програмні результати навчання

РН01. Мати сучасні концептуальні та методологічні знання з фізики та/або астрономії та дотичних до них міждисциплінарних напрямів, а також необхідні навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань та/або здійснення розробок та інновацій.

РН02. Аналізувати та оцінювати стан і перспективи розвитку фізики та/або астрономії, а також дотичних міждисциплінарних напрямів.

РН05. Розробляти моделі процесів і систем у фізиці та/або астрономії та дотичних міждисциплінарних напрямах, використовувати їх у науково-дослідницькій діяльності для отримання нових знань та/або створення розробок та інноваційних продуктів.

РН06. Планувати і виконувати прикладні та/або фундаментальні дослідження фізики та/або астрономії та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних методів, методик, технологій, інструментів та обладнання, з дотриманням норм академічної етики, критично аналізувати результати наукових досліджень у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; готувати проектні пропозиції щодо фінансування наукових досліджень та/або розробницьких і інноваційних проектів.

РН10. Мати навички захисту прав інтелектуальної власності.

РН11. Організовувати освітній процес і проводити педагогічну діяльність у сфері фізики та/або астрономії, забезпечувати відповідне наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення.

У результаті засвоєння матеріалу дисципліни аспірант повинен:

Знати

- 1) Основні закономірності яким підпорядковуються взаємодія носіїв струму із зовнішніми полями, що впливають на кристал.
- 2) Основні особливості, що характеризують напівпровідники, метали, діелектрики;
- 3) Розуміти сутність фізичних ефектів і явищ, властивих для напівпровідників;

- 4) Механізми взаємодії прискорених частинок із твердотільними об'єктами;
- 5) Методи модифікації характеристик напівпровідників та приладів на їх основі.

Вміти

- 1) Ставити та розв'язувати задачу, яка стосується одержання інформації про властивості радіаційних дефектів у конкретному напівпровіднику;
- 2) Розраховувати режими опромінення;
- 3) Скласти програму досліджень впливу опромінення кристалів;
- 4) Розробляти технологію радіаційного впливу на зразок з метою цілеспрямованої зміни його фізичних властивостей

Передумови для навчання

Перелік попередньо прослуханих дисциплін / Знання, вміння, навички, якими повинен володіти здобувач, щоб приступити до вивчення дисципліни

Для успішного засвоєння дисципліни аспірант повинен мати ґрунтовні знання, вміння і навички з дисциплін математичного і фізичного спрямування, які входять до стандартної програми підготовки бакалаврів на фізичних (радіофізичних) факультетах ВНЗ, а також вільно користуватись персональним комп'ютером. Компетентності, знання, уміння та досвід, одержані в процесі вивчення кредитного модуля «Радіаційна фізика напівпровідників», є необхідними для розуміння фізичних процесів, що відбуваються при високих енергіях за рахунок сильної та електромагнітної взаємодій, а також проведення сучасних фундаментальних досліджень та виконання розрахунків величин, що вимірюються на провідних експериментальних установках із вивчення ядер та елементарних частинок.

Зміст навчальної дисципліни

Дисципліна структурно складається з трьох розділів:

Розділ 1. Основні принципи фізики твердого тіла

Розділ 2. Взаємодія проникного випромінювання з кристалами

Розділ 3. Релятивістські взаємодії

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни

Для виконання практичних завдань за темою курсу потрібен лише персональний комп'ютер, підключений до мережі Інтернет. Ця вимога легко задовольняється для аспірантів ІЯД НАН України за рахунок наявного обладнання у відділах, де виконується наукова робота, а також за рахунок особистої комп'ютерної техніки аспірантів. Отже, кожний аспірант має необхідні умови для виконання завдань курсу.

**Сторінка курсу на платформі
Інституту (персональна
навчальна система)**

Рекомендовані джерела

Базова література:

1. Фелдман Л, Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких пленок. М.: Мир, 1989.
2. Оцуки Ё. Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. М.: Мир, 1985.
3. Ланно М., Бургуэн Ж. Точечные дефекты в полупроводниках. Теория. М.: Мир, 1984.
4. Вавилов В. С., Кив А. Е., Ниязова О. Р. Механизмы образования и миграции дефектов в полупроводниках. М.: Наука, 1981

Допоміжна література:

1. Ланно М., Бургуэн Ж. Точечные дефекты в полупроводниках. Экспериментальные аспекты. М. Мир, 1985
2. Вавилов В. С., Киселев В. Ф. Дефекты в кремнии и на его поверхности. М.: Наука, 1990.

Навчальний контент

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Загальний методичний підхід до викладання навчальної дисципліни визначається як комунікативно-когнітивний та професійно орієнтований, згідно з яким у центрі освітнього процесу знаходиться аспірант – суб'єкт навчання і майбутній науковець.

Лекційні заняття

Розділ 1. Основні принципи фізики твердого тіла

Тема 1. Зонна теорія твердого тіла. Адіабатичне наближення. Зони Брилюєна. Рух електронів у кристалі. Ефективна маса, Структура зон класичних напівпровідників.

Тема 2. . Статистика електронів і дірок. Функція розподілу Фермі-Дірака. Рівень заповнення домішкових станів. Власний напівпровідник. Температурна залежність рівня Фермі. Домішкові зони.

Тема 3. Оптика напівпровідників. Поглинання світла. Правила Урбаха. Екситони. Люмінесценція. Механізми рекомбінації . Стимульоване випромінювання. Твердотільні лазери. Світлодіоди.

Розділ 2. Взаємодія проникного випромінювання з кристалами

Тема 1. Розсіяння важких частинок. Система центра мас. Передана енергія. Потенціали міжатомних взаємодій (Борна-Майєра, Томаса-Фермі-Дірака, Ленарда-Джонса). Межі застосування класичного підходу

Тема 2. Переріз та імовірність розсіяння. Ймовірність віддачі. Імпульсне розсіяння. Наближення твердих сфер.

Тема 3. Зіткнення з нейтронами. Анізотропія розсіяння. Величина переданої енергії. Кадмієве відношення. Ефект Вігнера. Радіаційне розпухання (свеллінг). Принцип ядерного легування напівпровідників.

Тема 4. Каскадні зміщення. Модель Кінчена-Піза. Каскадна функція. Атомна концентрація зміщень

Тема 5. Модель Зейтца-Харрісона. Особливості опромінення важкими зарядженими частинками (протонами, легкими та важкими йонами, уламками поділу) , а також нейтронами різних енергій

Розділ 3. Релятивістські взаємодії

Тема 1. Опромінення швидкими електронами. Модель Мак-Кінлі-Фешбаха. Перерізи взаємодії. Допорогове дефектоутворення. Опромінення гамма-квантами.

Тема 2. Модель Брейта-Вігнера. Ширина ліній. Ймовірність взаємодії. Резонансне захоплення нейтронів.

Розподіл реакторних нейтронів за енергіями. Метод одержання ультрахолодних нейтронів.

Тема 3. Підсумки курсу.

Практичні заняття

Заняття 1. Вступ до зонної теорії

Заняття 2. Обробка статистичних даних для функції розподілу Фермі-Дірака

Заняття 3. Вивчення електричних та оптичних властивостей світлодіодних структур

Заняття 4-6. Відвідування науково-технічного експериментального комплексу Інституту, а саме У-240, У-120, ЕГП-10, НГ- 11, ВВЕР-1000, РТУ

Самостійна робота аспіранта

Самостійна робота здобувача наукового ступеня доктора філософії є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від навчальних занять час і включає:

Вид самостійної роботи	Кількість годин СРС
Підготовка до поточних практичних занять	15
Виконання поточних практичних завдань	15
Опанування матеріалів лекцій та додаткових питань із застосування основної та додаткової літератури	34
Індивідуальні консультації з викладачем	4

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Система вимог, які викладач ставить перед аспірантом:

- правила відвідування занять: заняття проводяться відповідно до розкладу згідно із правилами, встановленими [Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті ядерних досліджень НАН України](#), присутність на заняттях є добровільною, примушування до будь-яких дій в навчальному процесі без особистої згоди аспіранта не допускається. Відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни бали нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних та практичних заняттях згідно з [Уніфікованою системою оцінювання навчальних досягнень аспірантів](#).
- правила поведінки на заняттях: аспірант має можливість отримувати бали за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни. Використання засобів зв'язку для пошуку інформації на гугл-диску викладача, в інтернеті, в дистанційному курсі на платформі Інституту здійснюється за умови вказівки викладача;
- політика дедлайнів та перескладань: якщо аспірант не виконував модульні контрольні роботи (без поважної причини), то його результат оцінюється у 0 балів. Перескладання передбачено за поважних причин;
- політика щодо академічної доброчесності: [Положення про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти в Інституті ядерних досліджень НАН України](#) встановлює загальні моральні принципи, правила етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що працюють і навчаються в Інституті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;
- при використанні цифрових засобів зв'язку з викладачем (мобільний зв'язок, електронна пошта, переписка на форумах та у соцмережах тощо) необхідно дотримуватись загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.

Система оцінювання результатів навчання

Види контролю та система оцінювання результатів навчання

Поточний контроль: бліц-опитування на лекції за темою попередньої лекції, опитування і перевірка домашніх завдань на практичних заняттях, оцінювання рефератів та їх презентацій перед аудиторією.

Підсумковий контроль: іспит (залік).

Умови допуску до підсумкового контролю: допускаються усі аспіранти, крім тих, чий поточні знання оцінені на “незадовільно” (0 – 29 балів).

Рейтинг аспіранта з дисципліни складається з балів, які він отримує:

- 1) на лекційних та практичних заняттях (опитування і перевірка домашніх завдань);
- 2) за відповіді на іспиті (заліку).

Система рейтингових балів

1) Практичні та лекційні заняття.

Теоретичне питання (бліц-опитування): кожна правильна і змістовна відповідь – 1 бал, максимальна кількість балів за семестр – 4 бали.

Теоретичне питання (ускладнене): кожна правильна і змістовна відповідь – 2 бали, максимальна кількість балів за семестр – 8 балів.

Розв'язування задач: кожне правильне розв'язання – 4 бали, максимальна кількість балів за семестр – 8 балів.

Вибірковий контроль домашніх завдань: кожне правильно виконане домашнє завдання – 5 балів, максимальна кількість балів за семестр – 10 балів.

2) Відвідування лекцій та семінарів.

Кожна відвідана лекція (1 акад. година) – 0,5 бала, максимально за семестр – 8 балів.

Кожне відвідане практичне заняття (1 акад. година) – 0,5 бала, максимально за семестр – 7 балів.

3) Підготовка і презентація рефератів.

Повнота розкриття теми – максимально 10 балів.

Якість підготовленої презентації і виступу перед аудиторією (до 10 хв.) – максимально 5 балів.

4) Іспит (Залік).

Критерії оцінювання. Завдання містить 2 основні теоретичні питання, кожне з яких оцінюються у 10 балів (максимум) та 2 задачі (чи додаткові запитання), які оцінюються у 10 балів. Всього $2 \cdot 10 + 2 \cdot 10 = 40$ балів (максимум).

Нарахування балів за відповідь на теоретичне питання:

- повна розгорнута відповідь (не менше 90 % потрібної інформації) – 10 балів;
- достатньо повна відповідь (не менше 75 % потрібної інформації) – 8 балів;
- неповна відповідь (не менше 60 % потрібної інформації) – 4 бали;
- незадовільна відповідь (менше 60 % потрібної інформації) – 0.

Нарахування балів за розв'язання задачі:

- правильний кінцевий результат і повне пояснення – 10 балів;
- неправильний кінцевий результат, але правильний підхід – 5 балів;
- нерозв'язана задача – 0.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни			
Види навчальної роботи		Мах кількість балів	
Навчальна активність на лекційних та практичних заняттях		60	
Іспит		40	
Максимальна кількість балів		100	
Відповідність системи оцінювання ІЯД НАН України шкалі оцінювання ЄКТС та національній системі оцінювання			
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), практики, тренінгу	
		для заліку	
		відмінно	
		добре	
		задовільно	
90 – 100	A	зараховано	
82 – 89	B		
74 – 81	C		
64 – 73	D		
60 – 65	E		
		достатньо	

35 – 59	FX	незадовільно	не зараховано
1 – 34	F		
<i>Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни, див. сайт ІЯД.</i>			

Силабус затверджено на засіданні вченої ради ІЯД НАН України.

« 8 » жовтня 2024 р. Протокол № 10.